

Final datasheet

IHM-B Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode

Eigenschaften

- Elektrische Eigenschaften
 - $V_{CES} = 3300 \text{ V}$
 - $I_{C\text{ nom}} = 1200 \text{ A} / I_{CRM} = 2400 \text{ A}$
 - Hohe Stromdichte
 - Große DC-Festigkeit
 - Hohe Kurzschlussrobustheit
 - Niedrige Schaltverluste
 - Niedriges V_{CEsat}
 - $T_{vj\text{ op}} = 150^\circ\text{C}$
 - Trench IGBT 4
 - Sehr große Robustheit
 - V_{CEsat} mit positivem Temperaturkoeffizienten
 - Niedriges Q_g und C_{res}
- Mechanische Eigenschaften
 - ALSiC Bodenplatte für erhöhte thermische Lastwechselfestigkeit
 - Hohe Leistungsdichte
 - Isolierte Bodenplatte
 - Gehäuse mit CTI > 600
 - RoHS konform



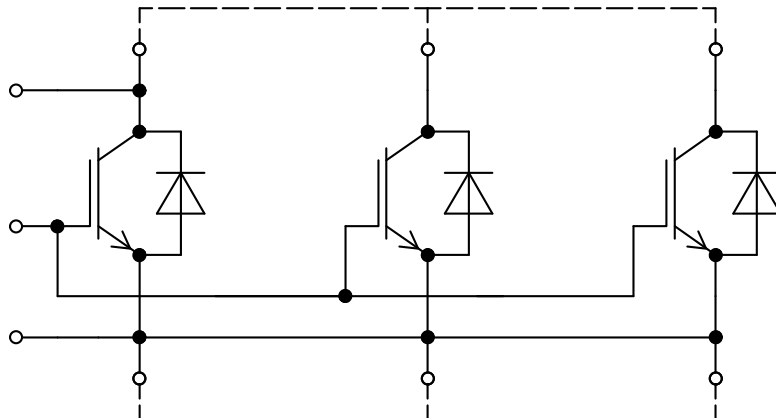
Potenzielle Anwendungen

- Hochleistungsumrichter
- Mittelspannungsantriebe
- Motorantriebe
- Traktionsumrichter
- USV-Systeme
- Aktiver Eingang (Rückspeisung)

Produktvalidierung

- Qualifiziert für Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749 und 60068

Beschreibung



Inhalt

	Beschreibung	1
	Eigenschaften	1
	Potenzielle Anwendungen	1
	Produktvalidierung	1
	Inhalt	2
1	Gehäuse	3
2	IGBT, Wechselrichter	3
3	Diode, Wechselrichter	5
4	Kennlinien	7
5	Schaltplan	11
6	Gehäuseabmessungen	11
7	Modul-Label-Code	12
	Änderungshistorie	13
	Disclaimer	14

1 Gehäuse

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Isolations-Prüfspannung	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$	6.0	kV
Teilentladungs-Aussetzspannung	V_{isol}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $Q_{PD} \leq 10 \text{ pC}$	2.6	kV
Kollektor-Emitter-Gleichsperrspannung	$V_{CE(D)}$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$, 100 Fit	2100	V
Material Modulgrundplatte			AlSiC	
Kriechstrecke	$d_{Creep \text{ nom}}$	Kontakt - Bodenplatte, nom.	32.2	mm
Luftstrecke	$d_{Clear \text{ nom}}$	Kontakt - Bodenplatte, nom.	19.1	mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	CTI		> 600	

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Modulstreuinduktivität	L_{sCE}			6		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{AA'+CC'}$	$T_C = 25 \text{ °C}$, pro Schalter		0.08		mΩ
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{CC'+EE'}$	$T_C = 25 \text{ °C}$, pro Schalter		0.14		mΩ
Lagertemperatur	T_{stg}		-40		150	°C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage	M	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	M6, Schraube	4.25	5.75	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse	M	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	M4, Schraube	1.8	2.1	Nm
			M8, Schraube	8	10	
Gewicht	G			1200		g

2 IGBT, Wechselrichter

Tabelle 3 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	V_{CES}		$T_{vj} = -40 \text{ °C}$	3300	V
			$T_{vj} = 150 \text{ °C}$	3300	
Kollektor-Dauergleichstrom	I_{CDC}	$T_{vj \text{ max}} = 150 \text{ °C}$	$T_C = 105 \text{ °C}$	1200	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom	I_{CRM}	t_p begrenzt durch $T_{vj \text{ op}}$		2400	A

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 3 (Fortsetzung) Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Gate-Emitter-Spitzenspannung	V_{GES}		± 20	V

Tabelle 4 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$V_{CE\ sat}$	$I_C = 1200\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	2.40	2.65	V
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	2.95		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	3.10	3.25	
Gate-Schwellenspannung	V_{GEth}	$I_C = 47\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\text{ °C}$	5.20	5.80	6.40	V
Gateladung	Q_G	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, V_{CC} = 1800\text{ V}$		20		μC
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		1		Ω
Eingangskapazität	C_{ies}	$f = 1000\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		140		nF
Rückwirkungskapazität	C_{res}	$f = 1000\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ °C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		4		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom	I_{CES}	$V_{CE} = 3300\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		5	mA
Gate-Emitter-Reststrom	I_{GES}	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$			400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{don}	$I_C = 1200\text{ A}, V_{CC} = 1800\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 1.2\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.540		μs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	0.670		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	0.700		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	$I_C = 1200\text{ A}, V_{CC} = 1800\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 1.2\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.210		μs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	0.230		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	0.230		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{doff}	$I_C = 1200\text{ A}, V_{CC} = 1800\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 6.2\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	3.900		μs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	4.200		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	4.300		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	$I_C = 1200\text{ A}, V_{CC} = 1800\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 6.2\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	0.800		μs
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	1.400		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	1.500		
Einschaltzeit (ohmsche Last)	t_{on_R}	$I_C = 500\text{ A}, V_{CC} = 2000\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 1.2\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1.20		μs
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	$I_C = 1200\text{ A}, V_{CC} = 1800\text{ V}, L_\sigma = 85\text{ nH}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 1.2\text{ }\Omega, di/dt = 4400\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150\text{ °C})$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	1680		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	2490		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	2750		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 4 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	$I_C = 1200\text{ A}, V_{CC} = 1800\text{ V}, L_\sigma = 85\text{ nH}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 6.2\text{ }\Omega, dv/dt = 1450\text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		1760		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		2320		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$		2490		
Kurzschlussverhalten	I_{SC}	$V_{GE} \leq 15\text{ V}, V_{CC} = 2400\text{ V}, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$t_P \leq 10\text{ }\mu\text{s}, T_{vj} \leq 150\text{ }^\circ\text{C}$		5200		A
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	R_{thJC}	pro IGBT				11.9	K/kW
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	R_{thCH}	pro IGBT, $\lambda_{grease} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$			4.70		K/kW
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\text{ op}}$			-40		150	°C

3 Diode, Wechselrichter

Tabelle 5 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}		$T_{vj} = -40\text{ }^\circ\text{C}$		3300		V
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$		3300		
Dauergleichstrom	I_F				1200		A
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	$t_P = 1\text{ ms}$			2400		A
Grenzlastintegral	I^2t	$t_P = 10\text{ ms}, V_R = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		630		kA ² s
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$		570		
Spitzenverlustleistung	P_{RQM}	$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$			3600		kW
Mindesteinschaltdauer	t_{onmin}				10		µs

Tabelle 6 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_F	$I_F = 1200\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		2.60	3.00	V
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		2.30		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$		2.20	2.50	
Rückstromspitze	I_{RM}	$V_{CC} = 1800\text{ V}, I_F = 1200\text{ A}, V_{GE} = -15\text{ V}, -di_F/dt = 4400\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		1280		A
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		1460		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$		1520		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 6 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

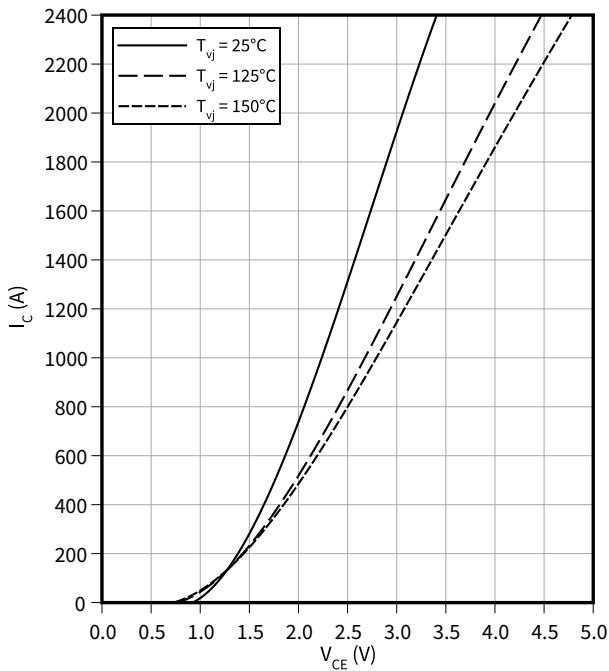
Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Sperrverzögerungsladung	Q_r	$V_{CC} = 1800\text{ V}, I_F = 1200\text{ A}, V_{GE} = -15\text{ V}, -di_F/dt = 4400\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		585		μC
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		1150		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$		1350		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	$V_{CC} = 1800\text{ V}, I_F = 1200\text{ A}, V_{GE} = -15\text{ V}, -di_F/dt = 4400\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		545		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		1230		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$		1460		
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	R_{thJC}	pro Diode				16.7	K/kW
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	R_{thCH}	pro Diode, $\lambda_{grease} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$			6.45		K/kW
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\text{ op}}$			-40		150	$^\circ\text{C}$

4 Kennlinien

Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{CE})$

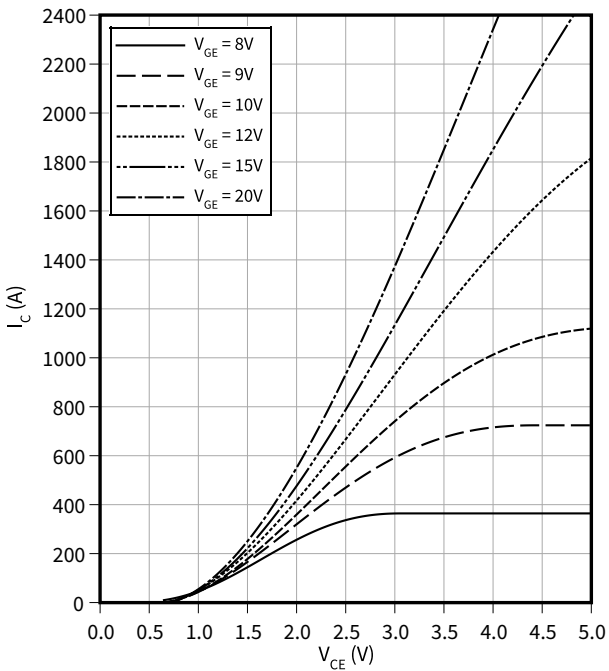
$V_{GE} = 15\text{ V}$



Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{CE})$

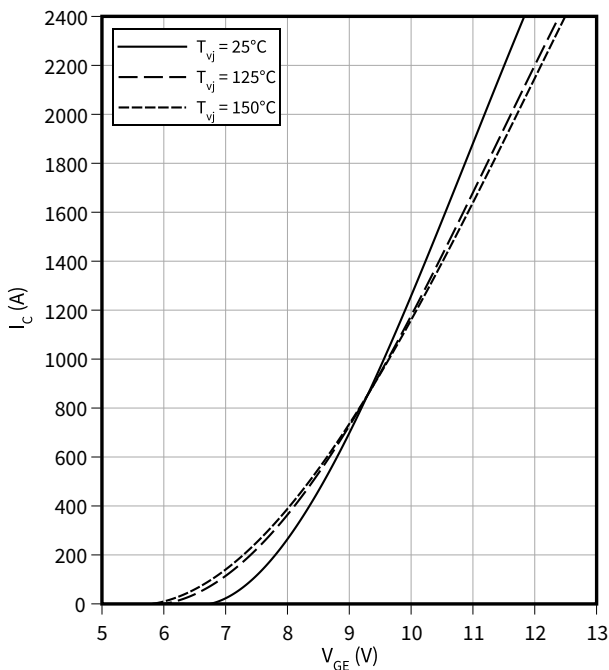
$T_{vj} = 150\text{ °C}$



Übertragungscharakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{GE})$

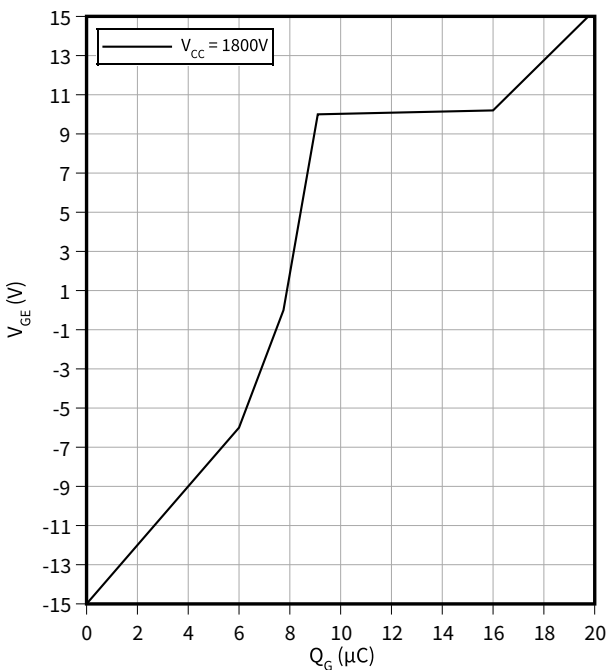
$V_{CE} = 20\text{ V}$



Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

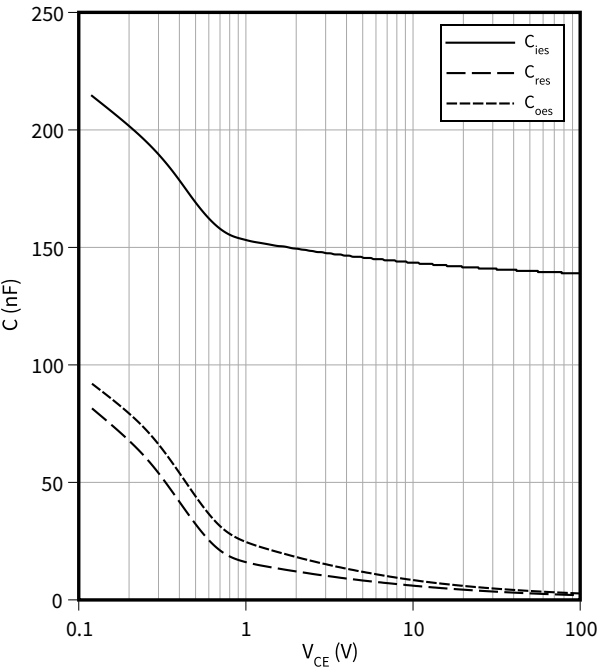
$V_{GE} = f(Q_G)$

$I_C = 1200\text{ A}, T_{vj} = 25\text{ °C}$



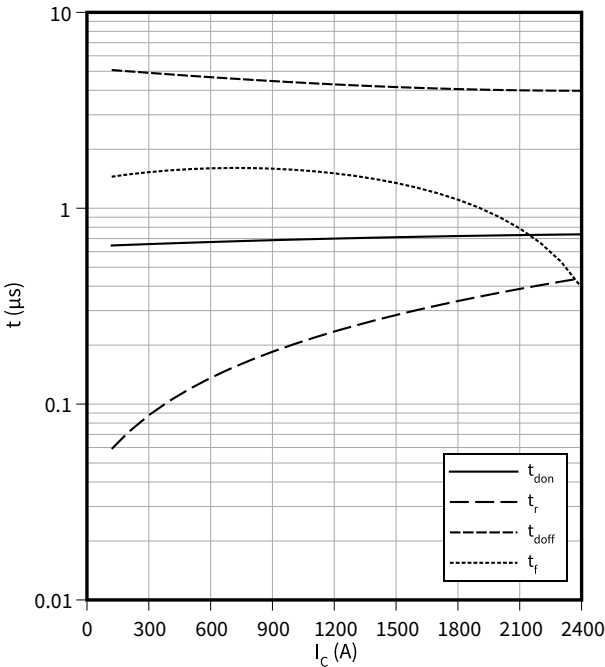
Kapazitäts Charakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

$C = f(V_{CE})$
 $f = 100\text{ kHz}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ °C}$



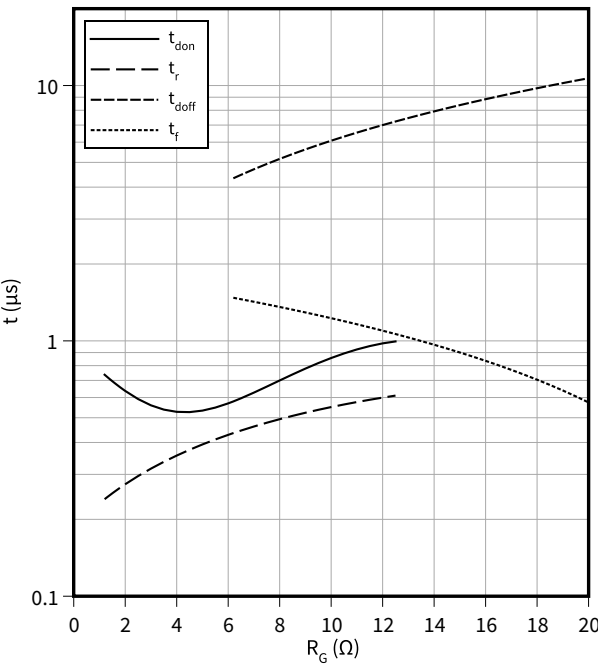
Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter

$t = f(I_C)$
 $R_{Goff} = 6.2\text{ }\Omega, R_{Gon} = 1.2\text{ }\Omega, V_{CC} = 1800\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, T_{vj} = 150\text{ °C}$



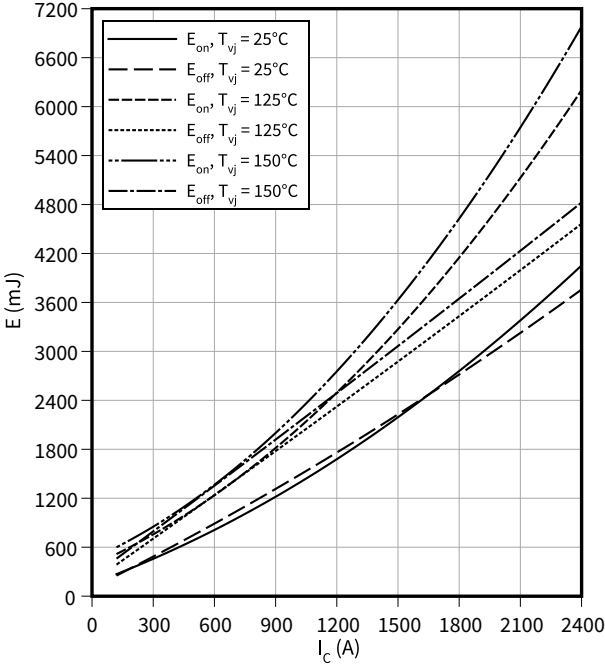
Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter

$t = f(R_G)$
 $I_C = 1200\text{ A}, V_{CC} = 1800\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, T_{vj} = 150\text{ °C}$



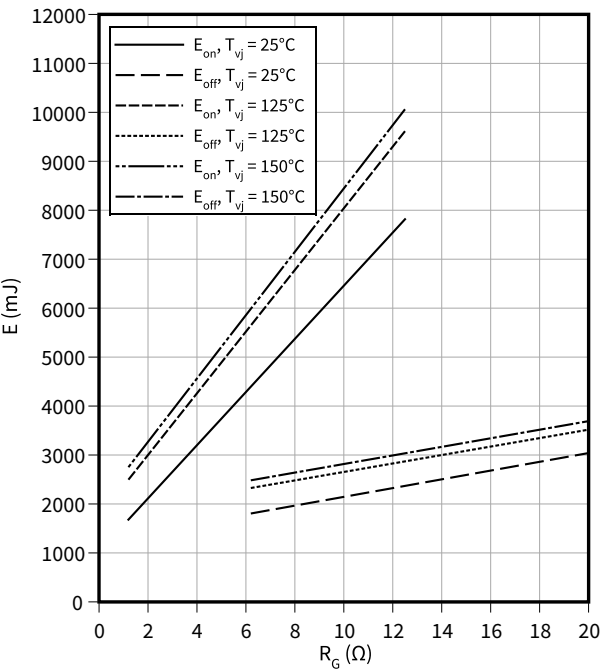
Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

$E = f(I_C)$
 $R_{Goff} = 6.2\text{ }\Omega, R_{Gon} = 1.2\text{ }\Omega, V_{CC} = 1800\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}$



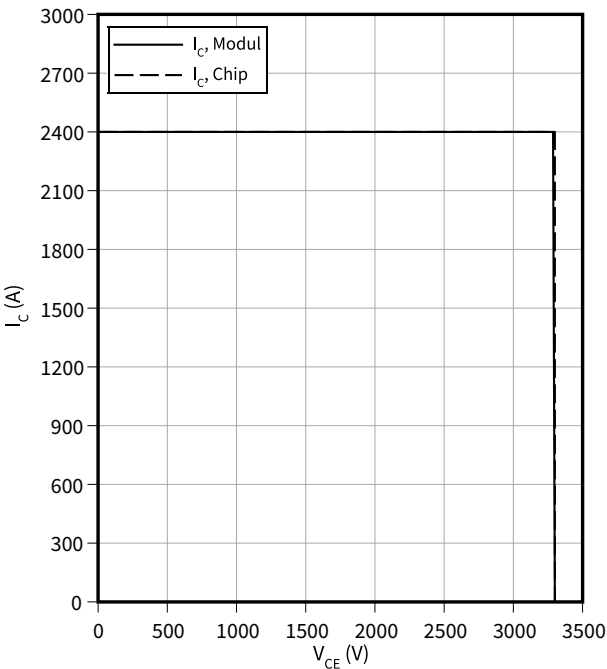
Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

$E = f(R_G)$
 $I_C = 1200\text{ A}$, $V_{CC} = 1800\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$



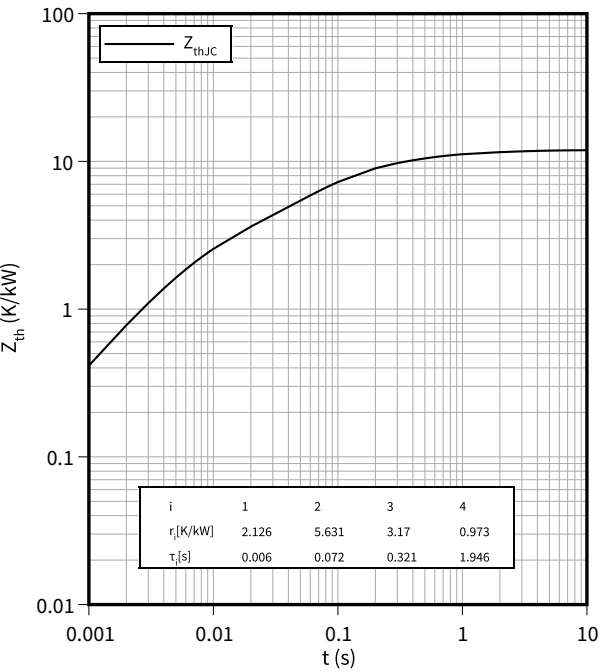
Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT, Wechselrichter

$I_C = f(V_{CE})$
 $R_{Goff} = 6.2\ \Omega$, $V_{GE} = 15\text{ V}$, $T_{vj} = 150\text{ °C}$



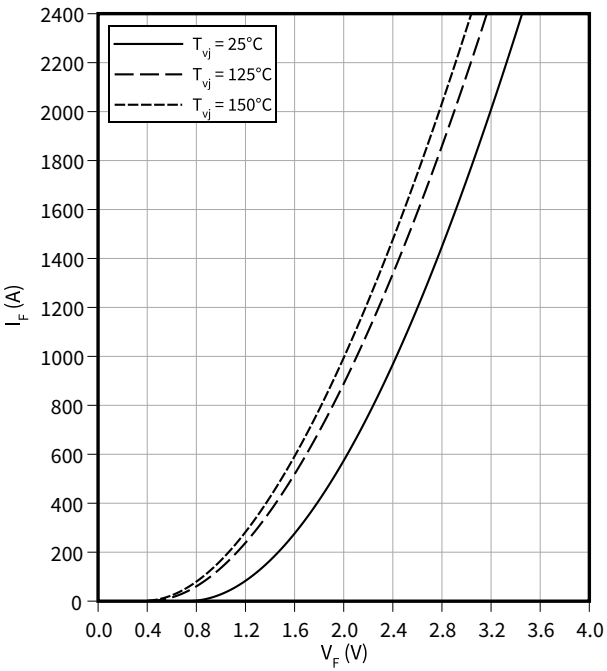
Transienter Wärmewiderstand, IGBT, Wechselrichter

$Z_{th} = f(t)$



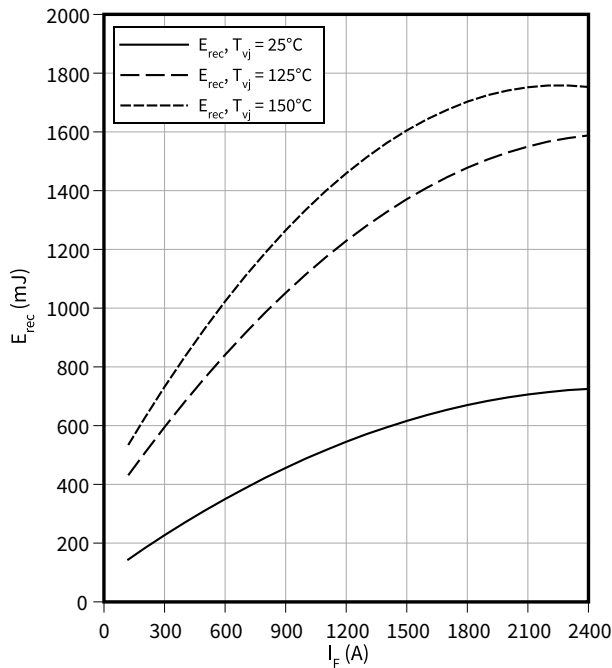
Durchlasskennlinie (typisch), Diode, Wechselrichter

$I_F = f(V_F)$



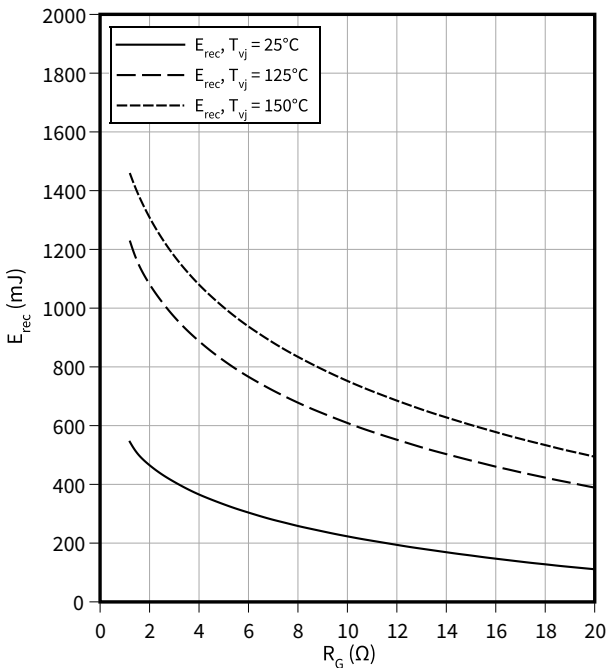
Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

$E_{rec} = f(I_F)$
 $V_{CE} = 1800\text{ V}, R_{Gon} = R_{Gon}(IGBT)$



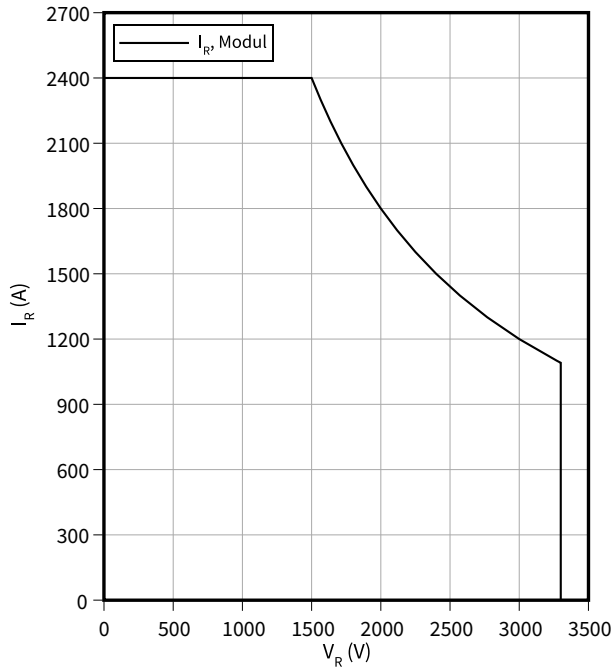
Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

$E_{rec} = f(R_G)$
 $V_{CE} = 1800\text{ V}, I_F = 1200\text{ A}$



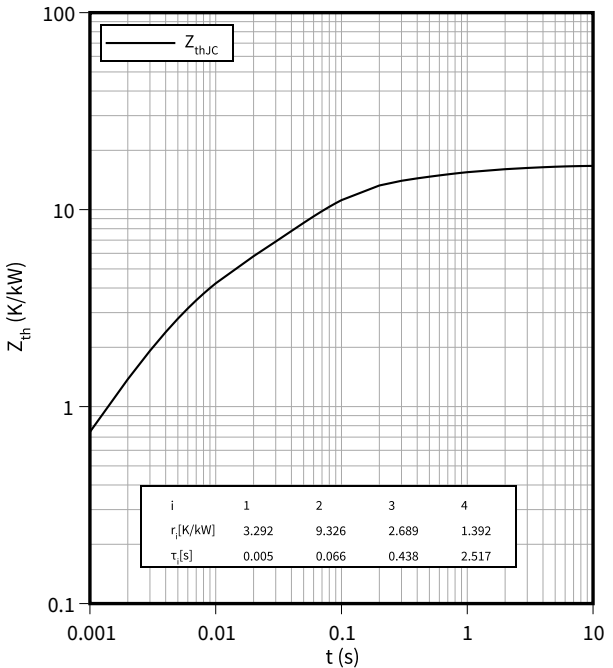
Sicherer Arbeitsbereich (SOA), Diode, Wechselrichter

$I_R = f(V_R)$
 $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



Transienter Wärmewiderstand, Diode, Wechselrichter

$Z_{th} = f(t)$



5 Schaltplan

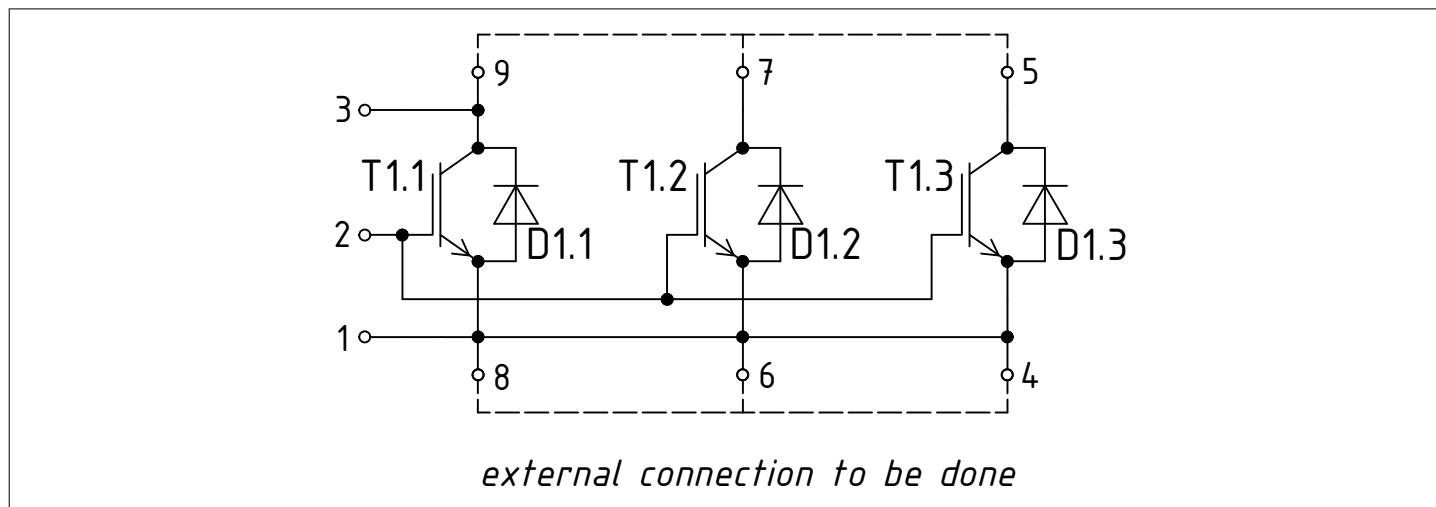


Abbildung 1

6 Gehäuseabmessungen

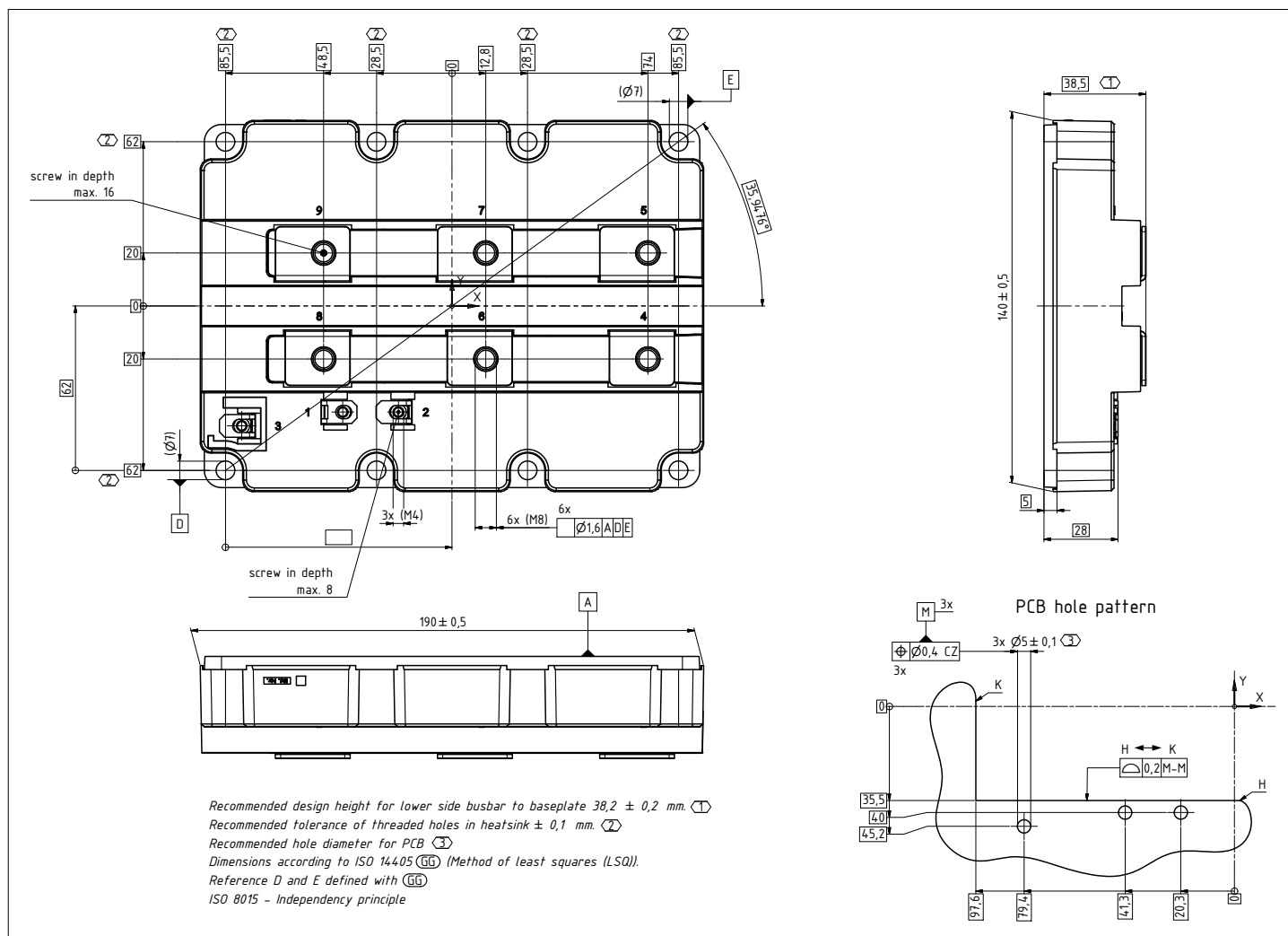


Abbildung 2

7 Modul-Label-Code

Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 – 5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 – 21	15
	Date code (production week)	22 – 23	30
Example	 7154914284655054991153071549142846550549911530		

Abbildung 3



Änderungshistorie

Dokumentenrevision	Freigabedatum	Beschreibung der Änderungen
0.10	2024-03-18	Initial version
1.00	2024-04-30	Final datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2024-04-30

Published by

Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany

© 2024 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-ABJ734-002

Wichtiger Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar.

Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument

enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht gemäß den AEC Q100 oder AEC Q101 Dokumenten des Automotive Electronics Council qualifiziert ist.

Warnhinweis

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.